

○経済産業省令第四十四号

外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第六十九条の五、輸出貿易管理令（昭和二十四年政令第三百七十八号）別表第一及び外国為替令（昭和五十五年政令第二百六十号）別表の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和六年七月八日

経済産業大臣 齋藤 健

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（平成三年通商産業省令第四十九号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ

ていないものは、これを加える。

改正後	改正前
<p>第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。</p> <p>一～七 「略」</p> <p>八 測定装置（工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。）<u>、位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であつて</u>、次のいずれかに該当するもの（第二号又は</p>	<p>第五条 輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。</p> <p>一～七 「略」</p> <p>八 測定装置（工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。以下この条において同じ。）<u>、位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であつて</u>、次のいずれかに該当するもの（第二号又は第三</p>

第三号に該当するものを除く。）

イ 「略」

ロ 直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の電子組立品であつて、次のいずれかに該当するもの（（一）及び（二）にあつては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。）

（一）～（三） 「略」

（四） （三）に該当する測定装置の電子組立品であつて、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの

ハ・ニ 「略」

号に該当するものを除く。）

イ 「略」

ロ 直線上の変位を測定する装置、直線上の位置のフィードバック装置又は測定装置の組立品であつて、次のいずれかに該当するもの（（一）及び（二）にあつては、レーザー干渉計及びレーザーを用いた光学エンコーダを除く。）

（一）～（三） 「略」

（四） （三）に該当する測定装置の組立品であつて、当該装置にフィードバック機能を付加するように設計したもの

ハ・ニ 「略」

九〇十一 「略」

第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

- 一 集積回路（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であつて、次のいずれかに該当するもののイ 「略」
- ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ

九〇十一 「略」

第六条 輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

- 一 集積回路（モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路（シリコンオンサファイア集積回路を含む。）、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。）であつて、次のいずれかに該当するもののイ 「略」
- ロ マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ

ータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路（ハからチまで若しくはルからカまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する

ータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路（ハからチまで若しくはルからワまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する

貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。）、FF Tプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであつて、次のいずれかに該当するもの（民生用の自動車又は鉄道車両用に設計した集積回路を除く。）

(一) ・ (二) 「略」

(三) 零下五五度以上一二五度以下の全ての温度範囲で使用することができるように設計したもの

ハクワ 「略」

カ 相補型金属酸化膜半導体集積回路であつ

貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。）、FF Tプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであつて、次のいずれかに該当するもの（民生用の自動車又は鉄道車両用に設計した集積回路を除く。）

(一) ・ (二) 「略」

(三) 零下五五度以上一二五度以下のすべての温度範囲で使用することができるように設計したもの

ハクワ 「略」

「新設」

て、零下二六八・六五度以下の温度で作動
するように設計したもの（ロに該当するもの
を除く。）

二 マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分
品であつて、次のいずれかに該当するもの

イ〜ヲ 「略」

ワ 周波数シンセサイザーを用いた電子組立
品のうち、次のいずれかに該当するもの

(一)〜(七) 「略」

カ 「略」

三〜九 「略」

十 アナログデジタル変換器のうち、アナログ
デジタル変換を行う機能を有するモジュール

二 マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分
品であつて、次のいずれかに該当するもの

イ〜ヲ 「略」

ワ 周波数シンセサイザーを用いた組立品の
うち、次のいずれかに該当するもの

(一)〜(七) 「略」

カ 「略」

三〜九 「略」

十 アナログデジタル変換器のうち、アナログ
デジタル変換を行う機能を有するモジュール

、電子組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であつて、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ・ロ 「略」

十一～十六の二 「略」

十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導

、組立品又は装置（アナログデジタル変換カード、波形デジタイザー、データ収集カード、信号収集ボード及びトランジェントレコーダーを含む。）であつて、次のイ及びロに該当するもの（デジタル方式の記録装置、サンプリングオシロスコープ、スペクトラムアナライザー、信号発生器、ネットワークアナライザー及びマイクロ波用試験受信機を除く。）

イ・ロ 「略」

十一～十六の二 「略」

十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導

体製造装置」という。)若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)

イ)ル「略」

ヲ ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキヤン方式の露光装置であつて、光学方式のものであり、かつ、光源の波長が一九三ナノメートル以上のもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(へ(一)2に該当するものを除く。)

体製造装置」という。)若しくは試験装置若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチクルであつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品若しくは附属品(次号に該当するものを除く。)

イ)ル「略」

ヲ ウエハーの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキヤン方式の露光装置であつて、光学方式のもものうち、光源の波長が一九三ナノメートル以上のものであり、かつ、ナノメートルで表した光源の波長に 0.25 を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が四五

(一) ナノメートルで表した光源の波長に〇・二五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が四五以下のもの

(二) 同一装置による重ね合わせ精度の最大値が二・四ナノメートル以下のもの

ワタ 「略」

レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 電気メッキ又は無電解メッキによりコバルトを成膜するように設計したものの

以下のもの（へ（一）2に該当するものを除く。）

「新設」

「新設」

ワタ 「略」

レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(一) 電気メッキによりコバルトを成膜するように設計したものの

(二) 化学的気相成長法によりコバルトを充填するように設計したもの又は選択性のボトムアップ成膜を用いる化学的気相成長法によりタングステンを充填するように設計したもの

(三) ～ (五) 「略」

(六) 仕事関数金属（トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。）を原子層堆積法により成膜するように設計した装置であつて、次の全てに該当するもの

- 1 二以上の金属の供給源を有するもの
のうち、アルミニウムの前駆体用に設

(二) コバルト又はタングステンをボトムアップ成膜によつて充填する工程において充填する金属の空隙又は継ぎ目の最大寸法が三ナノメートル以下となるように設計した化学的気相成長装置

(三) ～ (五) 「略」

(六) 仕事関数金属（トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。）の原子層堆積装置であつて、次の全てに該当するもの

- 1 次の全てに該当するもの

計した供給源を一以上有するもの

「削る」

「削る」

2|| 三〇度超の温度で作動するように設

計した前駆体容器を有するもの

3| 仕事関数金属を成膜するように設計した装置であつて、次の全てに該当するもの

一・二 「略」

一|| 二以上の金属の供給源を有するもの

のうち、アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を一以上有するもの

二|| 四五度超の温度で作動するように設計した前駆体容器を有するもの

「新設」

2| 仕事関数金属を成膜するように設計した装置であつて、次の全てに該当するもの

一・二 「略」

(七) ～ (九) 「略」

(十) ウエハ－の基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、配線の全体又は絶縁膜と絶縁膜との隙間（幅が四〇ナノメートル未満のものに限る。）にタングステンを原子層堆積法により充填するように設計したもの（(二)に該当するものを除く。）

ソクナ 「略」

ラ 成膜装置であつて、次のいずれかに該当するもの

(七) ～ (九) 「略」

(十) ウエハ－の基板温度を五〇〇度未満に維持しながら、絶縁膜と絶縁膜との隙間（幅に対する深さの比率が五倍を超え、かつ、当該幅が四〇ナノメートル未満のものに限る。）にタングステン又はコバルトを空隙が生じないように充填するように設計した原子層堆積装置（(二)に該当するものを除く。）

ソクナ 「略」

ラ 四〇〇度超六五〇度未満の温度で成膜する装置又はウエハ－が設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化

(一) ウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜するものであつて、シリコン及び炭素を含み、かつ、比誘電率が五・三未満の膜を、幅が七〇ナノメートル未満であり、当該幅に対する深さの比率が五倍を超え、かつ、パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満である水平方向の開口部に成膜する

学反応を促進させることで成膜する装置であつて、次の全てに該当するシリコン及び炭素を含む膜を形成するように設計したものの

(一) 五・三未満の比誘電率のもの

ように設計したものを

(二) 四〇〇度超六五〇度未満の温度で成膜するもの（シリコン及び炭素を含み、かつ、比誘電率が五・三未満の膜を、幅が七〇ナノメートル未満であり、当該幅に対する深さの比率が五倍を超え、かつ、パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満である水平方向の開口部に成膜するように設計したものに限り。）であつて、次の全てに該当するもの（(一)に該当するものを除く。）

1 垂直方向に積み重なつた複数のウエハーを保持するように設計されたボー

(二) 水平方向の開口部の寸法が七〇ナノメートル未満のパターンにおいて当該寸法に対する深さの比率が五倍を超えるもの

トを有するもの

2| 二以上の垂直方向に伸びるインジェクターを有するもの

3| 膜のシリコン原料及びプロペンが導入されるインジェクターと膜の窒素原料又は膜の酸素原料が導入されるインジェクターが異なるもの

「削る」

ム・ウ 「略」

キ 厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学

（三） パターンのピッチが一〇〇ナノメートル未満の構造のもの

ム・ウ 「略」

キ 厚さが一〇〇ナノメートル超であり、かつ、応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマにより成膜す

的気相成長法により成膜するように設計した装置

ノ 「略」

オ 金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が一倍以上のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置

ク 「略」

ヤ ○・○一パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ、銅の成膜を可能にするように設計した

るように設計した装置

ノ 「略」

オ 金属配線間の隙間（幅が二五ナノメートル未満であり、かつ、深さが五〇ナノメートル超のものに限る。）に比誘電率が三・三未満の低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置

ク 「略」

ヤ ○・○一パスカル以下の真空状態において、高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ、銅の成膜を可能にするように設計した

洗淨除去装置

マ 複数のチャンバー又はステーションを有する洗淨除去装置であつて、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したものを

ケ・フ 「略」

十七の二・十七の三 「略」

十七の四 半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡であつて、次のイからトまでの全てに該当するもの（国際半導体製造装置材料協会が定めたS

装置

マ 複数のチャンバー又はステーションを有する装置であつて、ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したもの又はドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したものを（ウに該当するものを除く。）

ケ・フ 「略」

十七の二・十七の三 「略」

「新設」

-
- EMI規格に準拠したウエハーの搬送・保管容器（二〇〇ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド（FOUP）を含む。）用にウエハー搬入部を設計したものを除く。）
 - ステージの位置決め精度が三〇ナノメートル未満のもの
 - レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能なもの
 - レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能なもの
 - 画素数が二〇〇、〇〇〇、〇〇〇〇を超え
る画像の収集及び保存が可能なもの
-

ホ 画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で五パーセント未満のもの

ヘ 画像を結合する際の視野の重なりが五〇ナノメートル未満のもの

ト 加速電圧が二一キロボルトを超えるもの

十八〜二十四 「略」

第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

- 一 電子計算機若しくはその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品

十八〜二十四 「略」

第七条 輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。

- 一 電子計算機若しくはその附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品

イ・ロ 「略」

二 「略」

三 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するよう
に設計した電子組立品であつて、次のロ、ハ
若しくはトのいずれかに該当するもの又はこ
れらの部分品（次のチからヌまでのいずれか
に該当するもの及びこれらの部分品を除く。）

イ・ロ 「略」

ハ デジタル電子計算機の機能を向上するよ
うに設計した電子組立品であつて、計算要
素を集合させることにより、加重最高性能

イ・ロ 「略」

二 「略」

三 デジタル電子計算機、その附属装置若しく
はデジタル電子計算機の機能を向上するよう
に設計した部分品であつて、次のロ、ハ若し
くはトのいずれかに該当するもの又はこれら
の部分品（次のチからヌまでのいずれかに該
当するもの及びこれらの部分品を除く。）

イ・ロ 「略」

ハ デジタル電子計算機の機能を向上するよ
うに設計した部分品であつて、計算要素を
集合させることにより、加重最高性能が七

が七〇実効テラ演算を超えるもの（最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。）

ニ〇又 「略」

四 電子計算機であつて、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品

イ〇ハ 「略」

五 「略」

六 量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 量子計算機であつて、次のいずれかに該

〇実効テラ演算を超えるもの（最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。）

ニ〇又 「略」

四 電子計算機であつて、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置若しくは部分品

イ〇ハ 「略」

五 「略」

「新設」

当するもの

(一) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを三四個以上一〇

〇個未満有するもので、C-NOTエラ

ーが〇・〇〇〇一以下であるもの

(二) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを一〇〇個以上二

〇〇個未満有するもので、C-NOTエ

ラーが〇・〇〇一以下であるもの

(三) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを二〇〇個以上三

五〇個未満有するもので、C-NOTエ

ラーが〇・〇〇二以下であるもの

(四) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを三五〇個以上五

〇〇個未満有するもので、C-NOTエ

ラーが〇・〇〇三以下であるもの

(五) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを五〇〇個以上七

〇〇個未満有するもので、C-NOTエ

ラーが〇・〇〇四以下であるもの

(六) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを七〇〇個以上一

一〇〇個未満有するもので、C-NO

Tエラーが〇・〇〇五以下であるもの

(七) 完全に制御され、接続され、使用

可能な物理量子ビットを一、一〇〇個以上二、〇〇〇個未満有するもので、C-NOTエラーが〇・〇〇六以下であるものの

(八) 完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを二、〇〇〇個以上有するもの

ロ 物理量子ビットのアレイを含む量子ビットデバイス又は量子ビット回路であつて、イに該当する貨物のために特に設計したものの

ハ 量子制御部品又は量子測定デバイスであつて、イに該当する貨物のために特に設計

したもの

第十九条 「略」

2 「略」

3 外為令別表の七の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～六 「略」

七 走査型電子顕微鏡により取得した画像から

GDSⅡデータ又はこれと同等の標準レイアウトデータを抽出し、当該データの層間位置合わせ機能を実行し、多層のGDSⅡデータ又は回路のネットリストを生成するために設計したプログラム

第十九条 「略」

2 「略」

3 外為令別表の七の項（三）の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。

一～六 「略」

〔新設〕

八|| ゲートオールアラウンド電界効果トランジ

スタ（G A A F E T）の構造を有する集積回

路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技

術（プログラムを除く。）であつて、次のい

ずれにも該当しないもの

イ|| プロセスデザインキット（第六条第一号

から第八号の四までのいずれかに該当する

貨物に係る機能又は技術を実装するライブ

|| ラリが含まれているものを除く。）

ロ|| ツールの認定又は保守に用いるもの

4・5 「略」

第二十条 外為令別表の八の項（一）の経済産業省

令で定める技術は、次のいずれかに該当するも

「新設」

4・5 「略」

第二十条 外為令別表の八の項（一）の経済産業省

令で定める技術は、次のいずれかに該当するも

の（セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術（プログラムを除く。）を除く。）とする。

一 第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）

二 第七条第一号から第五号までのいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

三 第七条第六号若しくはハに該当するものの設計又は製造に必要な技術（プログラムを

の（セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術（プログラムを除く。）を除く。）とする。

一 第七条各号に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術（プログラムを除く。）

二 第七条各号に該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）

〔新設〕

除く。)

四 第七条第六号ロ若しくはハに該当するもの

を設計し、若しくは製造するために設計した

プログラム又はそのプログラムの設計、製造

若しくは使用に必要な技術（プログラムを除

く。）

2 外為令別表の八の項（二）の経済産業省令で

定める技術は、次のいずれかに該当するもの（

第三号から第七号までに該当する技術（プログ

ラムを除く。）であつて、セキュリティの脆弱

性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを

除く。）とする。

一 「略」

「新設」

2 外為令別表の八の項（二）の経済産業省令で

定める技術は、次のいずれかに該当するもの（

第三号から第七号までに該当する技術（プログ

ラムを除く。）であつて、セキュリティの脆弱

性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを

除く。）とする。

一 「略」

二 デジタル電子計算機の機能を向上するよう
に設計した電子組立品であつて、計算要素を
集合させることにより、加重最高性能が二四
実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になる
ものに該当するものの設計又は製造に必要な
技術（プログラムを除く。）

三・四 「略」

五 デジタル電子計算機の機能を向上するよう
に設計した電子組立品であつて、計算要素を
集合させることにより、加重最高性能が二四
実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になる
ものを設計し、若しくは製造するために設計
したプログラム又はそのプログラムの設計、

二 デジタル電子計算機の機能を向上するよう
に設計した部分品であつて、計算要素を集合
させることにより、加重最高性能が二四実効
テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるもの
に該当するものの設計又は製造に必要な技術
（プログラムを除く。）

三・四 「略」

五 デジタル電子計算機の機能を向上するよう
に設計した部分品であつて、計算要素を集合
させることにより、加重最高性能が二四実効
テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるもの
を設計し、若しくは製造するために設計した
プログラム又はそのプログラムの設計、製造

<p>製造若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）</p> <p>六・七 「略」</p>	<p>若しくは使用に必要な技術（プログラムを除く。）</p> <p>六・七 「略」</p>
<p>備考 表中の「」は注記である。</p>	

附 則

（施行期日）

- 1 この省令は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
（罰則に関する経過措置）
- 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。